

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1995年 2月 2日

出 願 番 号

Application Number:

平成 7年特許願第037705号

出 願 人

Applicant (s):

株式会社半導体エネルギー研究所

1995年11月24日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Patent Office

清 川 佑



出証番号 出証特平07-3071628

【書類名】 特許願

【整理番号】 P002931-01

【提出日】 平成 7年 2月 2日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 21/00

【発明の名称】 レーザーアニール方法およびレーザー光の照射方法

【請求項の数】 6

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 楠本 直人

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 田中 幸一郎

【特許出願人】

【識別番号】 000153878

【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

【代表者】 山崎 舜平

【手数料の表示】

【納付方法】 予納

【予納台帳番号】 002543

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1